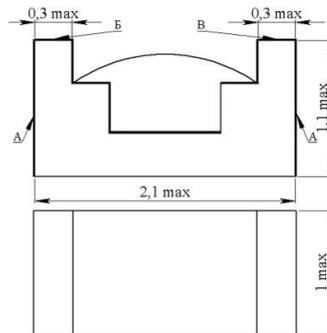


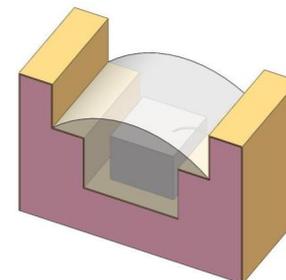
3A531A-6

Рабочий диапазон частот: 8.2 ÷ 12.4 ГГц;
 Рабочая температура окружающей среды: минус 60 °С ÷ 125 °С;
 Масса (не более): 0.01 г;
 Бескорпусное исполнение с контактными площадками
 Технические условия: аАО.339.019 ТУ

Диод полупроводниковый СВЧ бескорпусной арсенидогаллиевый переключательный планарно-эпитаксиальный с барьером Шоттки n-проводимости типа 3A531A-6, предназначенный для работы в составе гибридных интегральных микросхем, блоков и аппаратуры специального назначения.



А - металлизированная поверхность
 Б, В - контактные площадки



Электрические параметры при нормальной температуре окружающей среды

Тип диода	Критическая частота ^{1,2,3} , f _{кр} (ГГц)	Прямое сопротивление потерь ^{2,3} , r _{пр} (Ом)	Нормированное постоянное обратное напряжение, U _{нрм} (В)	Реактивное сопротивление при обратном смещении ^{1,3} , X (Ом)	Пробивное напряжение, U _{проб} (В)	Быстродействие, τ (нс)	Емкость диода ¹ , C _д (пФ)
3A531A-6	≥ 150	≤ 30	10	5÷20	≥ 12	≤ 1	0.15÷0.3

Примечание: 1) При U_{обр} = 5 В; 2) При I_{пр} = 10 мА; 3) При λ = 3.2 см.

Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, U_{обр max}, В

при T_{окр} = 25 °С - 10

при T_{окр} = 125 °С - 5

Максимально допустимый постоянный прямой ток, I_{пр max}, мА

при T_{окр} = 25 °С - 30

при T_{окр} = 125 °С - 10

Максимально допустимая рассеиваемая СВЧ мощность, P_{рас max}, мВт

при T_{окр} = 25 °С - 50

при T_{окр} = 85 °С - 30

при T_{окр} = 125 °С - 15

Максимально допустимая рассеиваемая импульсная СВЧ мощность, P_{и рас max}, мВт

при T_{окр} = 25 °С - 100

при T_{окр} = 125 °С - 20